# X線吸収文広報の紹介

Paul Fons Keio University

paulfons@keio.jp



# What is XAFS? (X-ray Absorption Fine-Structure)

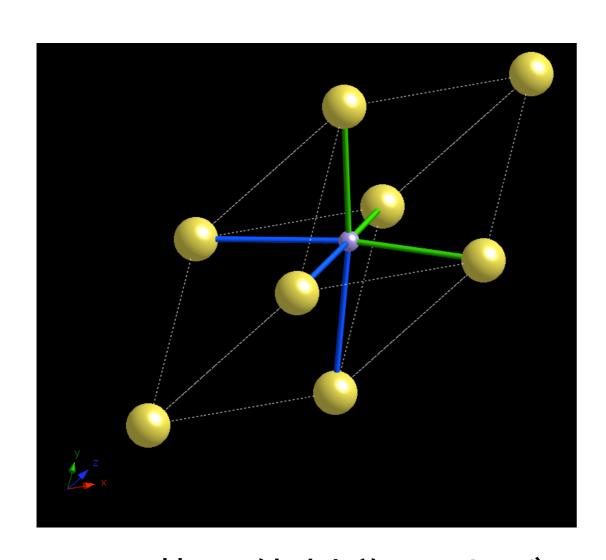
- XAFS (also XAS)は、吸収端の近くおよび上でのX線
  吸収係数の変調を指します。
- XAFSは元素選択的であり、吸収原子に関する局所的な原子環境を探索できます。

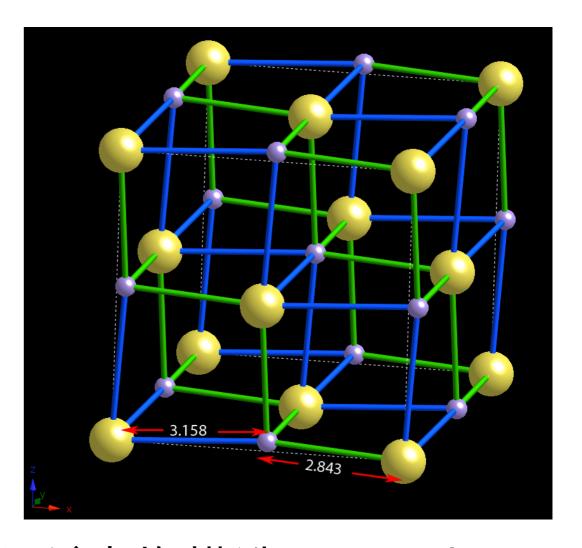
# XAFS 特性

- 元素選択的
- 局所的な原子配位
- 化学/酸化状態
- すべての要素に適用されます
- 低濃度で動作します
- 少量のサンプル(単層でも)

# ローカル構造とグ

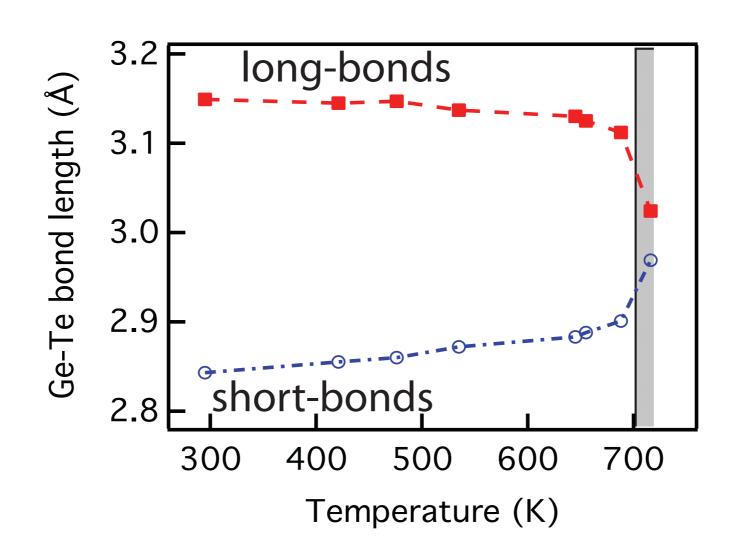
# GeTe "ideal" Structure





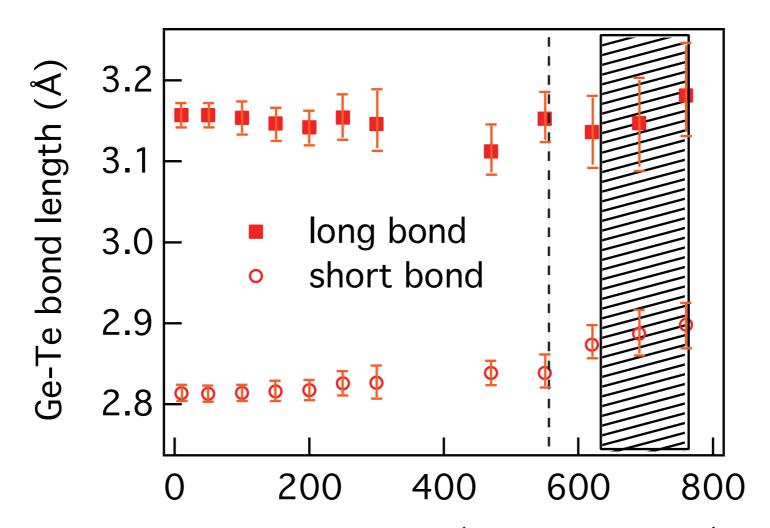
- 菱面体対称ですが、歪んだ岩塩構造としてより簡単に視覚化できます。
- 長いと短い結合あります

# GeTe 解說



● 粉末中性子回折は、平均構造から計算された長結 合と短結合がTcで等しくなることを示しています

# XAFS測定による

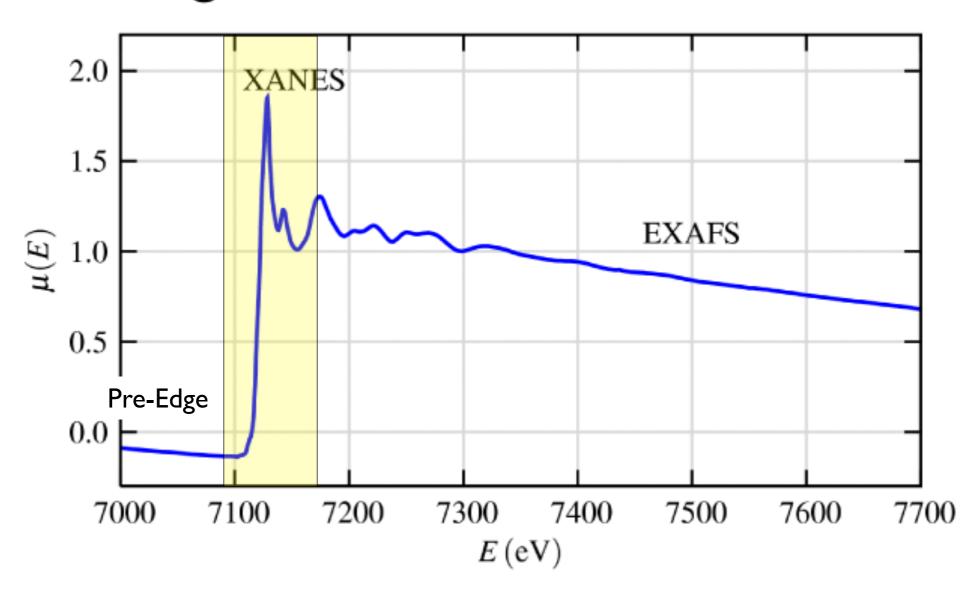


● 分析は、局所的な結晶構造がTcまでおよびそれを超えて菱 面体晶のままであることを示した。

XAFSはローカルであり、回折は(より長い)範囲のプローブです

### XAFS 例

#### Fe K-edge XAFS for FeO:



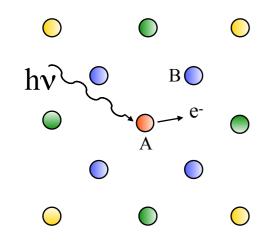
エッジ上のX線吸収の変調はXAFS信号を構成します

### XANES vs. EXAFS

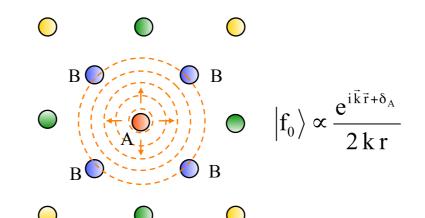
- XANES X線吸収端近傍分光法(0-40 eV)
- EXAFS 拡張X線吸収分光法(40-1000 eV)
- XANESとEXAFSは、同じスペクトルの2つの部分のラベルです。それらは、データの分析で使用される近似によって区別されます
- XANES 領域:光電子(PE)のエネルギーは小さく、平均自由行程は長く(nm)、PE相互作用は強く、より時間のかかるクラスター計算が必要です。 XANESは、コアから束縛状態への遷移です。
- EXAFS領域:PEエネルギーはより高く、散乱は、遭遇するEXAFS方程式によって十分に近似できる有限の一連の相互作用として扱うことができます。 EXAFSはコアから連続状態への移行です

### XAFSの視覚的解釈

#### Photon In

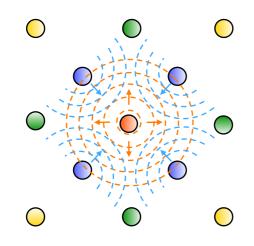


#### Photoelectron out



s状態のコアレベルの場合、 球面対称発信波動関数は吸 収原子から移動します

10



出て行く球面波は、隣接する原子の(クーロン)ポテンシャルによって散乱され、それ自体との干渉を引き起こします。 吸収原子は、光電子源と検出器の両方の役割を果たします。言い換えると、XAFS信号は、吸収原子に関する局所的な近傍を反映します

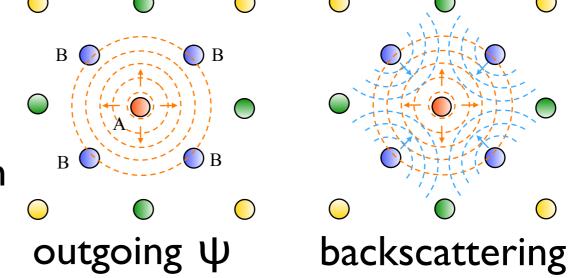
光電子は、移動距離と原子間ポテンシャルの両方に起因する位相シフトを経験することに注意してください(これにより、運動エネルギが増加するにつれてドブロイ波長 $\lambda$ が減少します)

# EXAFS: A simple picture

If  $\chi \sim \psi_{\rm scatt}(0)$  , we can understand by following the photoelectron

 $\Psi_P$ 's path

- $\psi_P$  leaves the absorbing atom
- part of  $\Psi_p$  scatters off a nearby atom
- returns to the absorbing atom



With a spherical wave  $e^{ikr}/kr$  for the outgoing photoelectron and a scattering atom at distance r=R,

$$\chi = \frac{e^{ikr}}{kr} \left[ 2kf(k)e^{i\delta} \right] \frac{e^{ikr}}{kr} + \text{C.C.}$$

where scattering from the neighboring atom gives rise to the amplitude f(k) and phase shift  $\delta(k)$  to the photoelectron

### The EXAFS Equation

EXAFS方程式は次の形式を取ります:

$$\chi(k) = \sum_{i} \frac{N_i S_0^2 f_i(k)}{k R_i^2} \sin(2kR_i + \delta_i(k)) e^{-2\sigma_i^2 k^2} e^{-2R_i/\lambda(k)}$$

合計は、原子のすべての「シェル」または光電子の「散乱経路」に適用されます。ここでは、原子のガウス分布を想定していることに注意してください。これは、ガラスなどの無秩序な材料の合併症につながり、キュムラントの方正によって対処できる場合があります。

次の散乱特性がわかっている場合  $f_i(k)$  and  $\delta(k)$  and  $\lambda(k)$ , 以下の数量を決定できます:

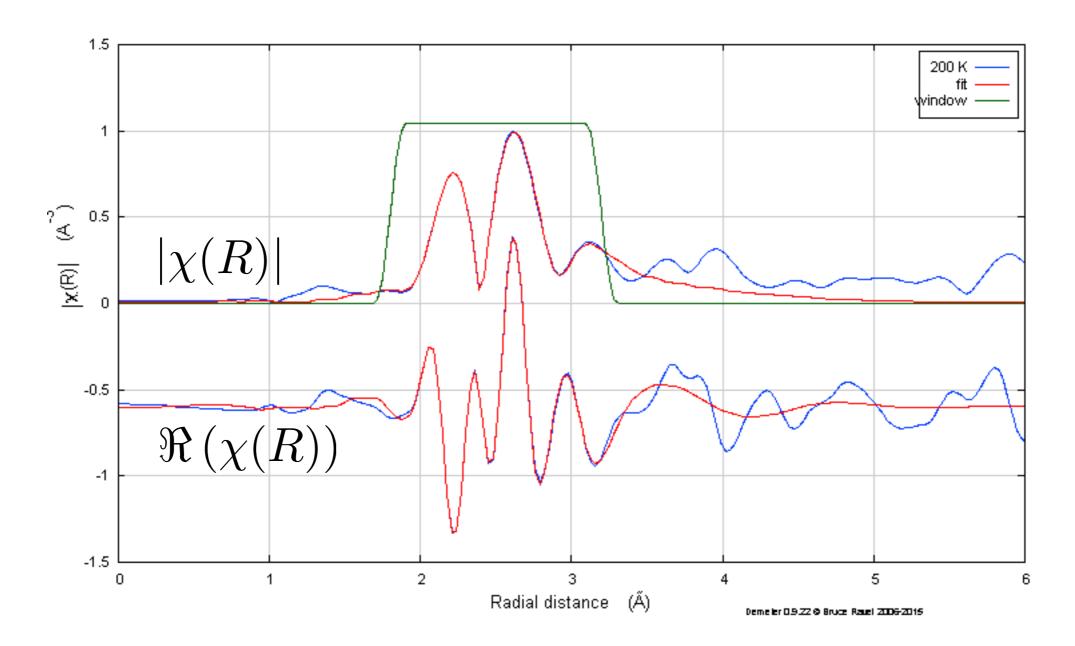
N 吸収原子に関する配位数

R最も近い原子までの距離

σ² 対応する隣接距離の二乗平均誤差

振幅 f(k)と位相シフト $\delta(k)$ は原子番号に依存するため、XAFSは隣接する原子のZにも敏感です

# GeTeフィット例



- 実空間フィット範囲 I.8 to 3.2 Å: r-factor = 0.00373
- 複素関数χの実数部と大きさを表示します